

CET-MOS

卓越的功率專家

10樓, 176號, 建康路, 中和區, 新北市 23585

電話:886-2-2222-9138

傳真:886-2-2222-3833

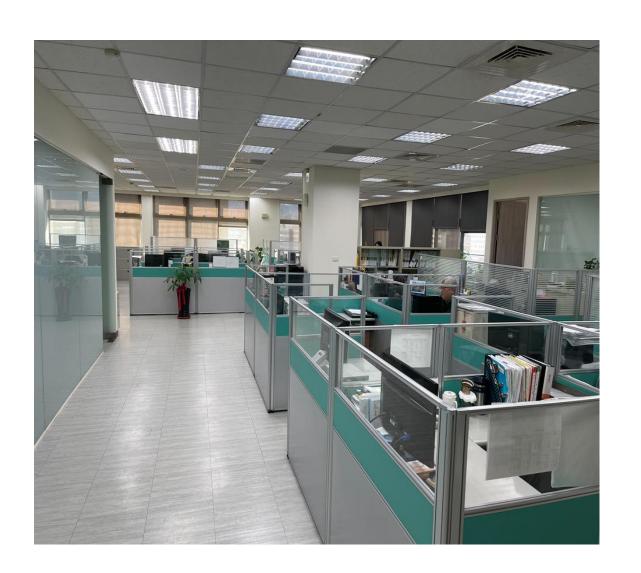
網站: https://www.cet-mos.com





- ■CET-MOS 是從 Chino-Excel Technology Corporation (CET) 獨立出來的公司, 承襲 CET 超過 40 年的技術與經驗。
- ■首家成功將 MOSFET 推廣至台灣市場,並持續引領業界發展。
- ■我們致力於設計與製造高品質的功率型 MOSFET,以卓越的技術實現最佳產品。



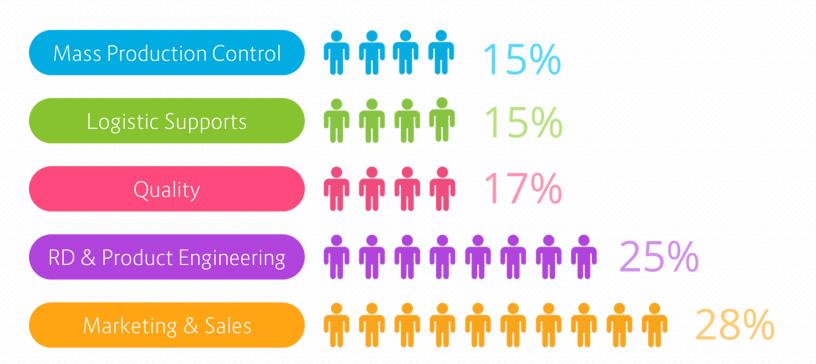


Copyright@2025 CET.MOS



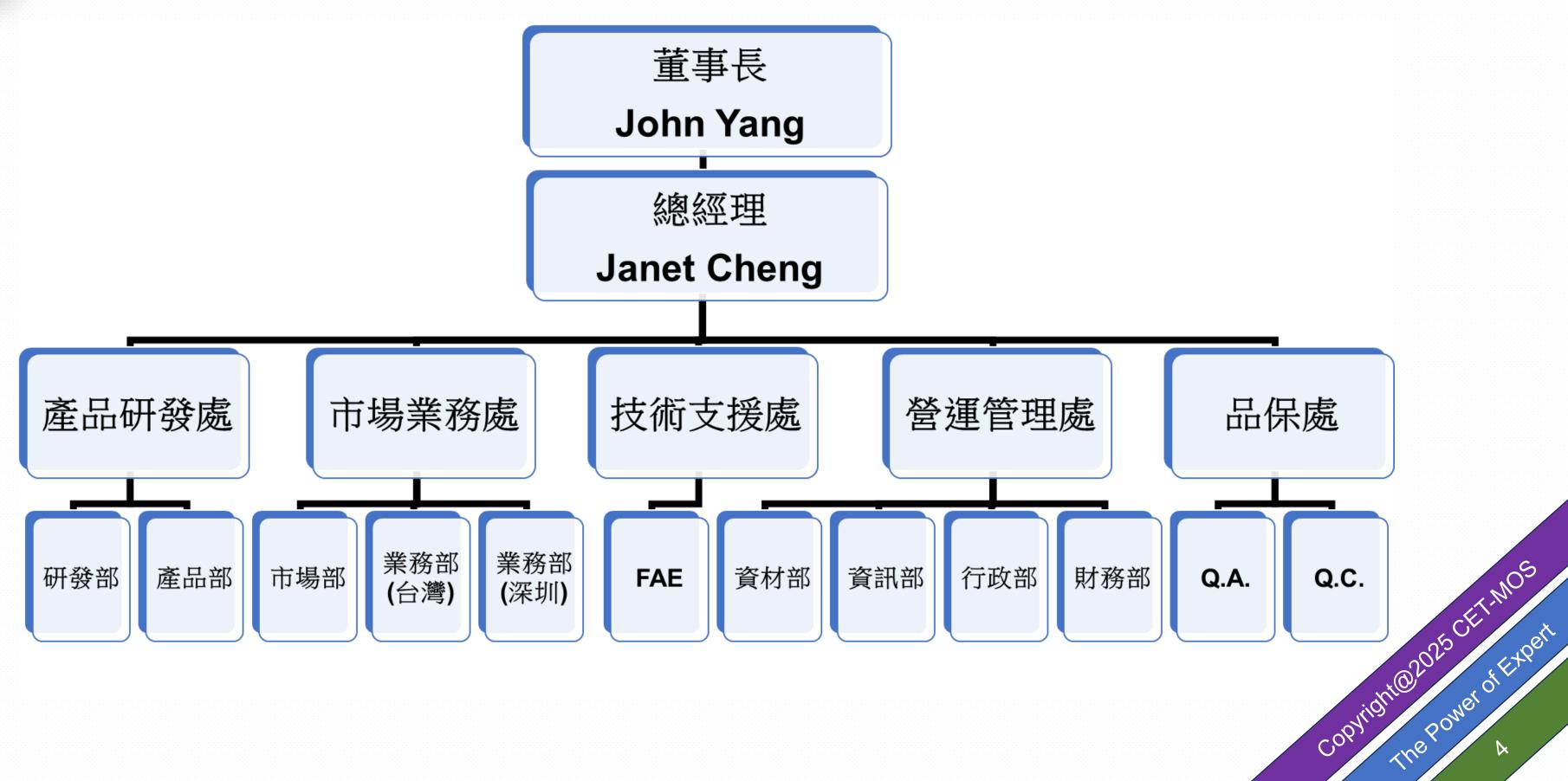


- ▶ 1984~ 創立,第一間組裝廠設立於台灣北部
- ▶ 1995~ 進入主機板市場,成為台灣首家 MOSFET 設計公司首次在台灣申請 MOSFET 專利
- ➤ 2005~獲 ASUS 綠色管理系統獎躋身 Salcomp (Nokia 供應商)前十大供應商
- ▶ 2012~ 獨立成立 CET-MOS, 遷入新辦公室,專注 於分立元件設計開發
- ▶ 2022~至今 提供最高品質與可靠性的產品以最佳的成本/效能比 ,滿足多元市場需求





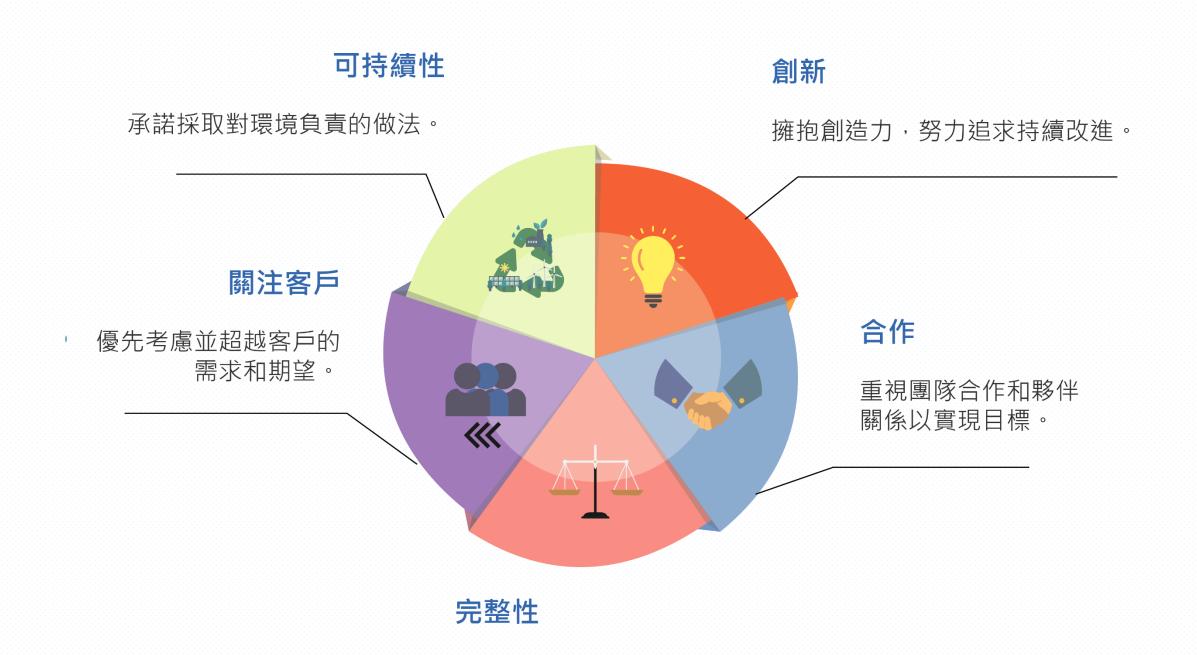




The Power of Expert

核心價值





以誠實和透明的方式開展業務。

copyright@2025 CET.MOS The Power of Expert





DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 6966-2003-AQ-RGC-RvA

Valid: 17 January, 2021 – 17 January, 2024

This is to certify that the management system of

CET-MOS Corporation

10F., No. 176, Jiankang Rd., Chung-Ho Dist., New Taipei City 23585, Taiwan and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard: ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Design and Production Management of Metal Oxide Silicon Field Effect

Shanghai, 21 December, 2020



For the issuing office: DNV GL – Business Assurance Suite A, Building 9, No.1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai 200336, P.R. China



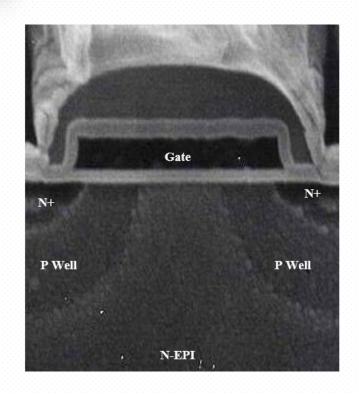
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid, ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLAI

		RoHS								
ASSEMBLY PROCESS	ASSEMBLY TYPE	Pb	Cd	Hg	Cr+6	PBDEs	PBBs	Phthalates (DBP, BBP, DEHP, DIBP)	REACH (SVHC)	Non-Halogen
Epoxy Process	SOT, SOP, TSOP, TSSOP, DFN	v	V	V	V	V	V	V	V	v
Solder Process	TO, PPAK	Pb>1000ppm Exemptions AnnexIII 7(a)	V	V	v	v	V	V	V	v

服 務 SERVICE 新 INNOVATION 動 DYNAMIC

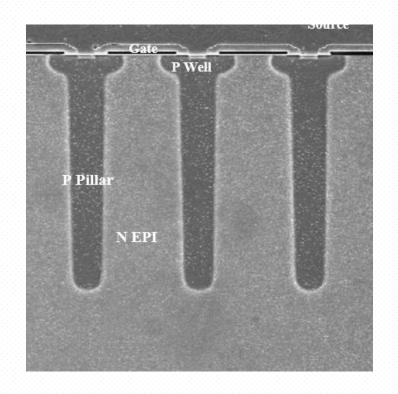
MOSFET 各種不同製程技術與產品特性應用





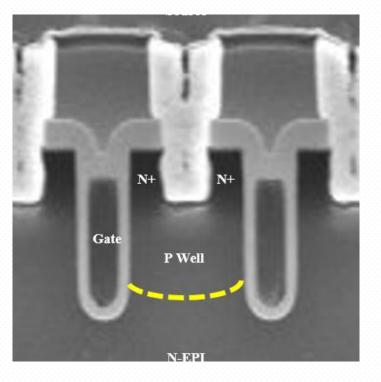
平面型(Planar)

- 高電壓、高功率
- 更高的 UIS (
 Unclamped
 Inductive
 Switching) 能力
- 低 Qgd (柵極-汲 極電荷)



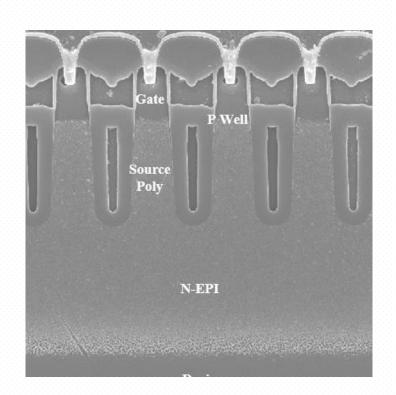
超結(Super Junction)

- 平面柵極結構
- 高耐壓 (Drain-Source Breakdown)
- 優異的 Rds(on)(導通 電阻)與 Qg(柵極電 荷)
- 高速開關特性



溝槽型(Trench)

- 高密度結構
- 更低的 Rds(on)
- 低 Qgd,適合縮小晶 片尺寸並降低成本



分離柵(Split Gate)

- 溝槽柵極結構
- 低壓或中等耐壓
- 超低 Rds(on)
- 更低的 Qgd / Qgs 比率, 提高開關性能

COPYright@2025

技術核心路線圖

~2025

~Now







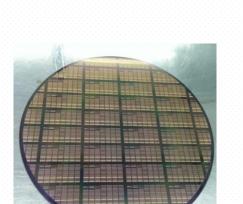
- > IGBT process with 300mm
- > SiC MOSFET (1700V)
 - GaN HEMT (e-mode)

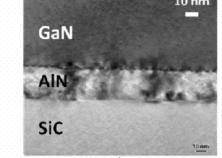


~2026

- Super Junction Device
 - Multi-EPI and Deep trench both process development.
 - 900V with FRD
 - G2 and G3A process upgrade Lower Rdson and Qrr/ Trr
- ➤ IGBT Device
 - Module Development
 - Lower Vcesat and high speed
 - RC (G1) process
- **➢ GaN HEMT (D-mode 650V)**
- > SiC Diode / MOSFET (650V / 1200V)
- Trench/ Split Gate MOSFETs (-200V~200V)
- > IGBT Device (650V / 1200V)
- > Super Junction Device (600V~900V)
- ➤ Planar MOSFET (30V~1500V)





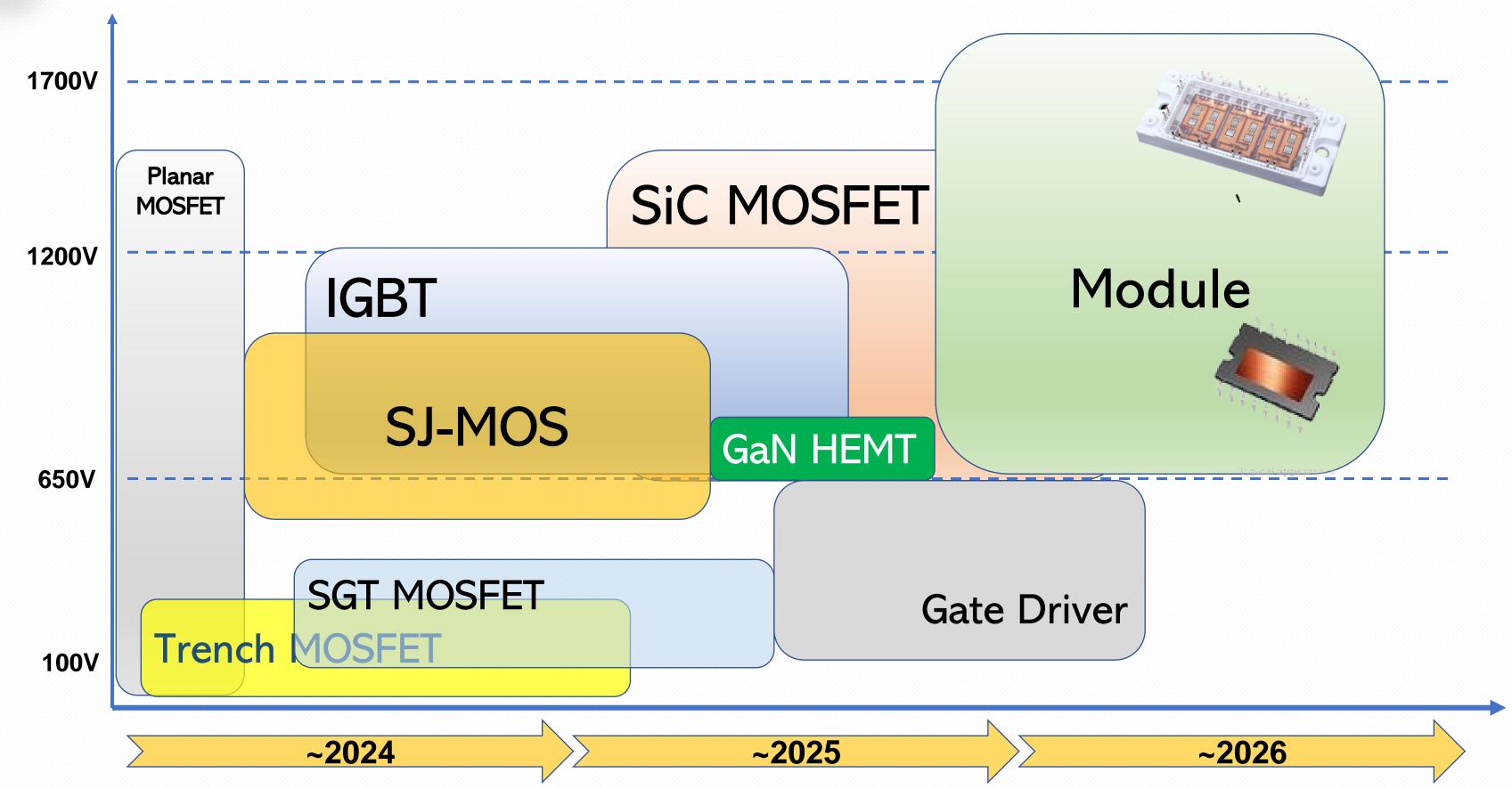


核心技術製程

Copyright © 2025 CET-MOS All rights reserved

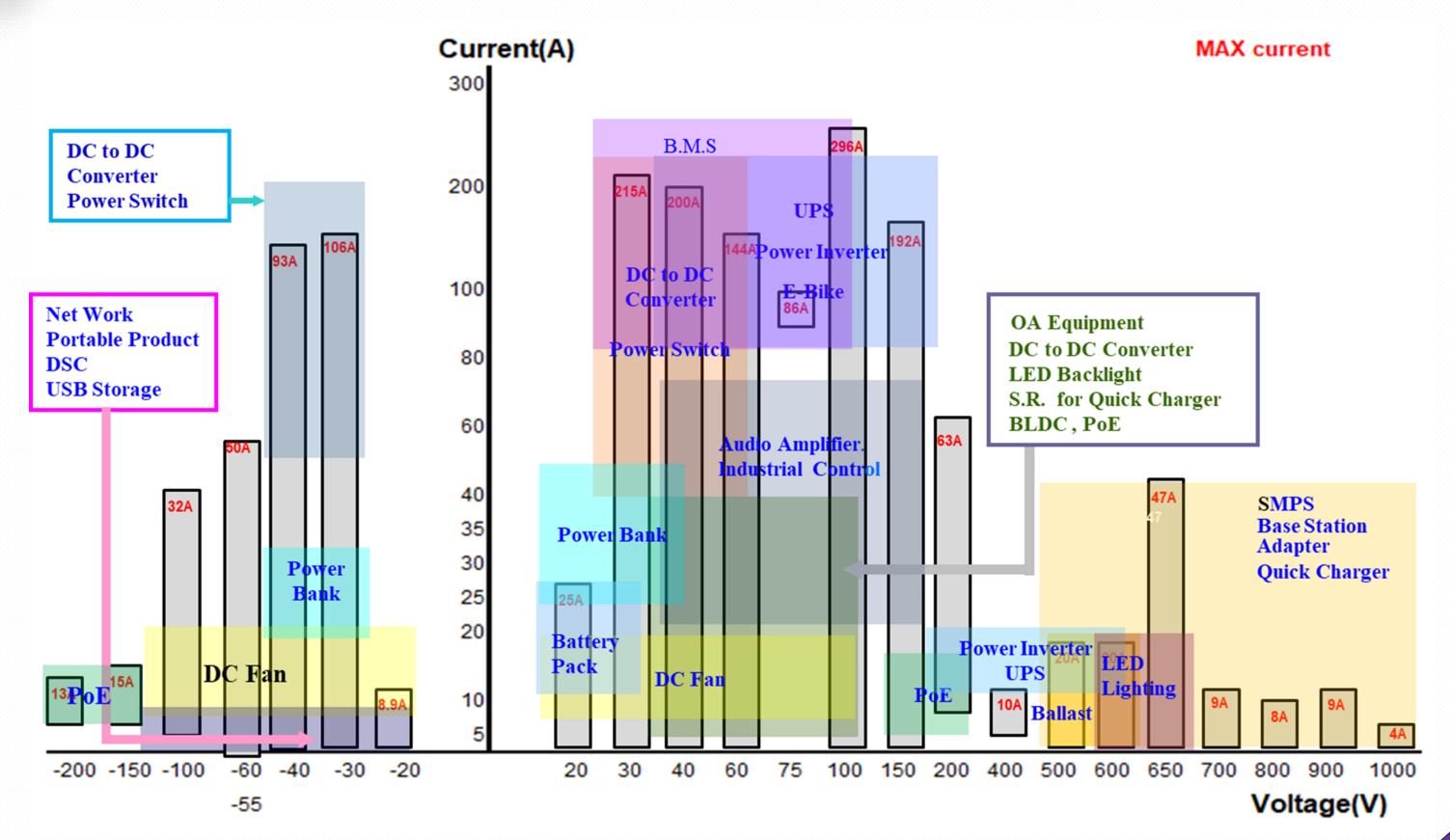
產品開發路線圖











Copyright@2025 CET.INOS

多樣化封裝產品



Products	LV/ MV MOSFETs	HV MOSFETs		
Vds (V)	-200 ~ 500	500 ~ 1000		
Packages	CET CET CET	CET CET		

OS CET.MI

OBALLS LIE BOM





≤30V	40V~250V	≥600V		
低壓 MOSFETs	中壓 MOSFETs	高壓 MOSFETs		
· 電池保護	· DC-DC 全橋轉換	· LLC 諧振轉換器		
· DC-DC 降壓轉換	· 同步整流	·功率因數校正		
· 馬達控制驅動	· 馬達控制驅動	· 光電太陽能逆變器		
· 負載開關	· 電源開關	· LED 照明		
· 主機板/筆記型電腦	· DC-DC 降壓轉換	·逆變器模組		
· 上下橋控制	· 電池反接保護	·混合動力/電動車		
· 繪圖卡	·基地台	· 家用電器		
· LED 監視器	· 汽車零組件	·基礎設施		
· 藍芽	· 乙太網路供電			
· 伺服器	· 不斷電系統			
· 乙太網路供電	· 電動工具			

CETIN

20 Shighter Some

主要應用領域

◆ 電池保護:安全開關

◆ 變流器/逆變器: DC/AC 轉換與負載開關

◆ 適配器/充電器/SPS: Flyback/Forward/LLC 開關

◆ LED 照明: Buck/Boost 開關

◆ 網路通訊: DC/DC 轉換與負載開關

◆ UPS(不斷電系統):高功率橋式開關

◆ 電動機/電動自行車:高功率橋式開關

◆ 顯示器與 LED 顯示屏: LED 開關

◆ VGA 轉換: DC/DC 轉換與負載開關







我們提供完整的功率半導體解決方案,涵蓋從 MOSFET、IGBT 到 GaN 及 SiC 技術,確保客戶獲得最佳的性能與成本效益。



COPYright@2025CET.MOS The Power of Expert





我們將持續深化技術創新,拓展市場應用,提升產品效能, 確保 CET-MOS 在功率半導體領域保持領先地位。



COPYright@2025 CET.MOS The Power of Expert



